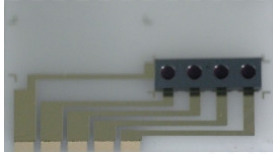
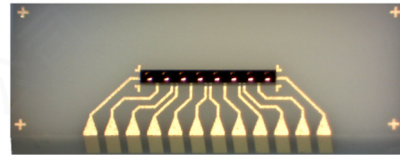


芯片+衬底 解决方案



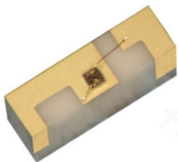
光电探测器阵列 + 衬底

- 四通道光电探测器倒装焊接在带有环绕式引线的陶瓷衬底
- 通道间距 250 μm
- 背部大光学孔径，易耦合
- 适用于激光监测和传感



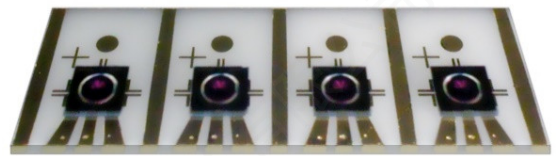
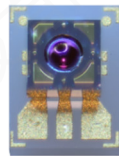
平衡光电探测器 + 衬底

- 八通道光电探测器倒装焊接在带有环绕式引线的陶瓷衬底
- 专为使用四对光电探测器进行平衡检测而设计的引线
- 背部大光学孔径，易耦合



单通道光电探测器 + 衬底

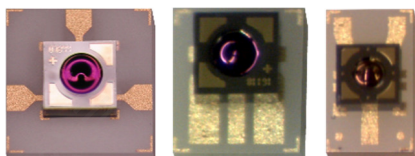
- 提供多种孔径尺寸: 60 μm , 80 μm , 150 μm , 300 μm
- 衬底带有环绕式金属接触面
- 高响应度
- 适用于激光监测



28 / 56 / 112 Gbaud

带集成镜头的光电探测器 + 衬底

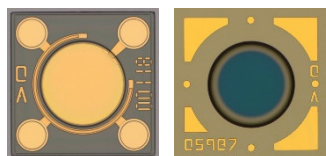
- 背部照明的超高速光电探测器倒装焊接于陶瓷衬底
- 光电探测器背部自带集成镜头，易于光耦合
- 可提供高精度，多通道贴装
- 用户可自定义衬底设计
- 每通道速率可达 28 Gbaud 至 112 Gbaud PAM
- 适用于 100G Single Lambda
- 适用于 400GBASE-DR4, 400G-FR4
- 适用于 800GbE



25G 雪崩光电探测器 + 衬底

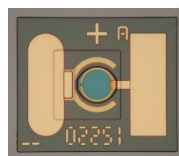
- 背部照明的 25G 雪崩二极管倒装焊接于陶瓷衬底
- 雪崩二极管背部自带集成镜头，易于光耦合
- 用户可自定义衬底设计
- 可用于实现高灵敏度的 25G 接收机
- 适用于 100GBASE-ER4

雪崩二极管 解决方案



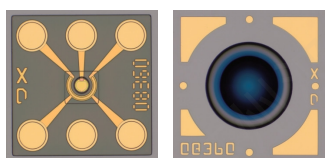
2.5G 背照 APD

- 低倍增噪音
- 高倍增响应
- 180 μm 的大光学孔径
- 可提供窄带滤光
- 适用于激光测距仪
- 适用于对人眼安全的扫描 LiDAR



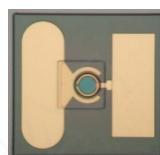
5G 正照 APD

- 实现了灵敏度高达 -35 dBm的光接收机
- 50 GHz 的高增益带宽积
- 27 V 的低工作偏压
- 专为打线接合而优化的大焊盘
- 适用于5G GPON



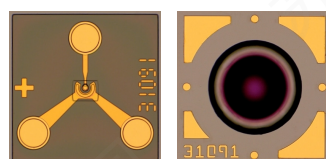
带镜头的 10G 背照 APD

- APD 背部自带集成镜头，易于光耦合
- 刷新纪录的灵敏度: -35 dBm (@ BER 1e-3)
- 提供芯片或带衬底的芯片(Chip-on-Submount)
- 可定制衬底
- 适用于10G PON



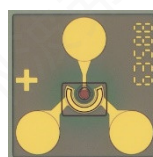
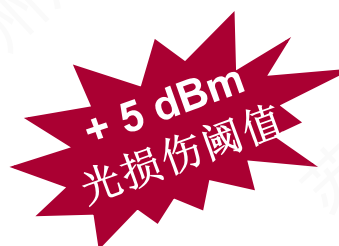
10G 正照 APD

- 实现了灵敏度高达 -29 dBm的光接收机
- 90 GHz 的高增益带宽积
- 29 V 的低工作偏压
- 小芯片尺寸: 280 x 270 μm^2
- 可提供通道间距为 250 μm 的 4x10G APD 阵列
- 适用于10G PON



带镜头的 28G 背照 APD

- APD 背部自带集成镜头，易于光耦合
- 实现了高灵敏度的 28G 光接收机
- 高达 +5 dBm 的光损伤阈值
- 提供芯片或带衬底的芯片(Chip-on-Submount)
- 可定制衬底
- 适用于 28 Gbaud PAM-4
- 适用于 100GBASE-ER4
- 适用于 25G EPON



28G 正照 APD

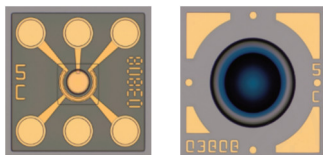
- 实现了高灵敏度的 28G 光接收机
- 高达 +5 dBm 的光损伤阈值
- 大动态范围
- 为 TO-can 组装而优化的芯片尺寸
- 适用于 28 Gbaud PAM-4
- 适用于 100GBASE-ER4
- 适用于 25G EPON



产品简介

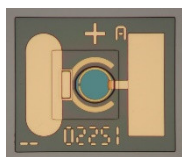
此简介所提供的信息如有更改，恕不另行通知。Albis Optoelectronics AG 对于未授权的更改及其导致的不准确之处不承担任何责任。版权所有 © 2021 Albis Optoelectronics AG。

人眼安全的 LIDAR 解决方案



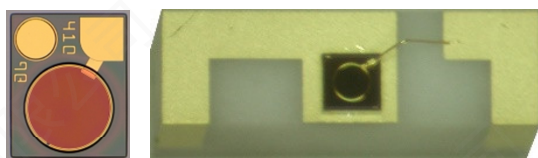
线性雪崩二极管 (APD)

- 背部集成大镜头 ($\varnothing 100\mu\text{m}$), 可提高光填充系数和光耦合效率
- 工作波长范围为 990nm 至 1650nm
- 光入口自带日光抑制功能
- 灵活的焊盘配置, 可支持打线接合或贴片
- 提供芯片或带衬底的芯片 (Chip-on-Submount)
- 适用于脉冲 time-of-flight (TOF) 系统



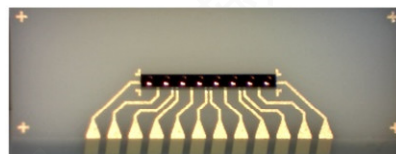
2.5G 正照 APD

- 低倍增噪声
- 高倍增响应
- $60\mu\text{m}$ 的大光学孔径, 易于光耦合
- 工作波长范围为 980nm 至 1650nm
- 适用于激光测距仪
- 适用于对人眼安全的扫描 LIDAR



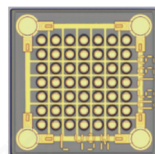
大面积监控用 p-i-n 和 APD

- 监控用 p-i-n 光电探测器拥有直径为 $300\mu\text{m}$ 的大感光面积
- 监控用 APD 光电探测器拥有直径为 $180\mu\text{m}$ 的大感光面积
- 可提供芯片或带环绕式衬底的芯片
- 针对监控应用进行了产品优化



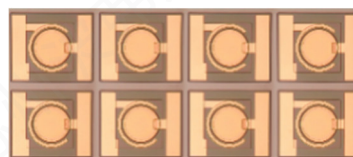
带衬底的平衡光电探测器阵列

- 四对平衡光电探测器贴片于带有环绕式金属引线的陶瓷衬底
- 通道间距为 $300\mu\text{m}$
- 适用于调频连续波 (FMCW) LIDAR



小间距 APD 阵列

- 二维多通道 APD 阵列
- $30\mu\text{m}$ 的超窄通道间距
- 可定制阵列布局
- 可定制用于日光抑制的窄带滤光涂层
- 适合 LIDAR 和成像应用



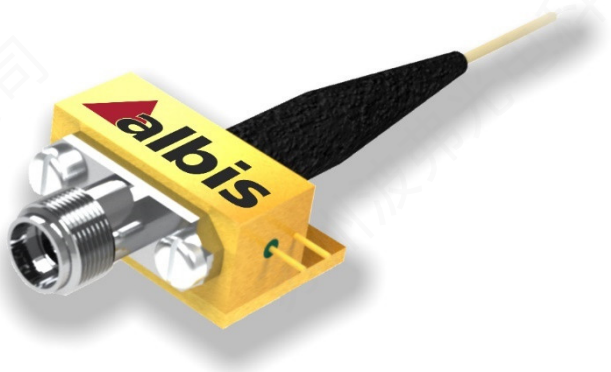
背照二维光电探测器阵列

- 可灵活组合阵列
- X 方向通道间距为 $300\mu\text{m}$, Y 方向通道间距为 $250\mu\text{m}$
- 背照大光学孔径, 易耦合
- 可定制衬底
- 适合 LIDAR 和传感应用

PQW 系列 - 气密封装的光电探测器

Albis 的 PQW 系列为其光电探测器芯片家族提供了一套小型、坚固且气密的封装，使得原有的探测器产品能够适应在恶劣环境条件下运行的系统。

PQW 光电探测器模块包含一个内置 bias-T，将探测器芯片连接到偏置电压输入和直流耦合后的 RF 信号输出。



PQW10A-L 10 GHz 光电探测器

- 带宽 > 10 GHz
- 内含高性能 Albis InGaAs p-i-n 光电探测器芯片
- 0.9 A/W 的高响应率
- 单模光纤尾纤

PQW20A-L 20 GHz 光电探测器

- 典型带宽: 23 GHz
- 内含高性能 Albis InGaAs p-i-n 光电探测器芯片
- 0.9 A/W 的高响应率
- 单模光纤尾纤

PQW30A-L 30 GHz 光电探测器

- 典型带宽: 30 GHz
- 内含高性能 Albis InGaAs p-i-n 光电探测器芯片
- 典型响应率: 0.8 A/W
- 单模光纤尾纤

PQW10A-S 10 GHz 短波光电探测器

- 带宽 > 10 GHz
- 内含高性能 Albis GaAs p-i-n 光电探测器芯片
- 0.6 A/W 的高响应率
- 工作波长 800 to 860 nm
- 多模光纤尾纤

PQW20B-L 20 GHz 高功率光电探测器

- 典型带宽: 22 GHz
- 内含高功率、高线性的 Albis 光电探测器芯片
- 高线性、低谐波失真
- 高 RF 输出功率: +15 dBm
- 大动态范围: -10 dBm 至 +20dBm 的光输入功率

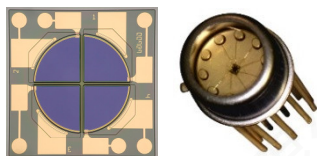
PQW30A-S 30 GHz 短波光电探测器

- 带宽 > 25 GHz
- 内含高性能 Albis GaAs p-i-n 光电探测器芯片
- 0.5 A/W 的高响应率
- 工作波长 800 to 860 nm
- 多模光纤尾纤

产品简介

此简介所提供的信息如有更改，恕不另行通知。Albis Optoelectronics AG 对于未授权的更改及其导致的不准确之处不承担任何责任。版权所有 © 2021 Albis Optoelectronics AG。

监测和传感解决方案



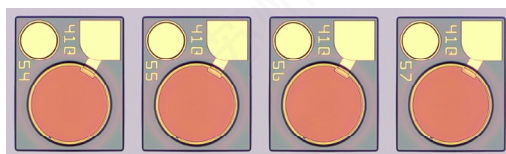
四象限光电探测器芯片

- 四个独立的有效探测区域
- 各区域拥有独立电极对
- 大感光面积
- 小间隙面积
- 在1550 nm 波长具有高响应
- 可提供 TO-can 封装
- 适用于位置检测和光束分析等领域



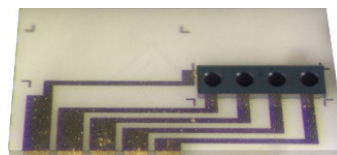
带陶瓷衬底的监测用光电探测器

- 300 μm 或 150 μm的大光学孔径
- 高响应度
- 陶瓷衬底带有环绕式的阴、阳极连接面
- 适用于激光监测



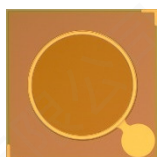
多通道顶部照明光电探测器阵列

- 250 μm 的通道间距
- 可灵活扩展通道数
- 直径 150 μm 的大光学孔径，易耦合
- 980 nm 至1620 nm 的超宽工作波长范围
- 适用于激光监测和传感



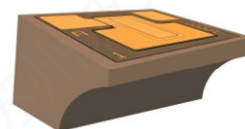
4 x 2.5G 背部照明光电探测器阵列

- 通道间距 250 μm
- 可灵活扩展通道数
- 背部大光学孔径，易耦合
- 适用于激光监测和传感
- 可提供倒装焊接（于带有环绕式引线的陶瓷衬底）



大面积光电探测器芯片

- 顶部照明
- 直径 300 μm 的大感光面积
- 针对监测领域的应用进行了产品优化
- 可提供贴片安装（于环绕式陶瓷衬底）



比之前更小了!

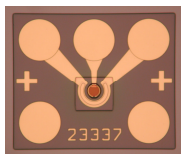
侧面照明的监测用光电探测器芯片

- 小尺寸，低成本
- 无需笨重且昂贵的环绕式衬底
- 弧形侧面，易于光耦合
- 1260 nm 至1620 nm 的较宽工作波长范围
- 适用于激光背面监测

产品简介

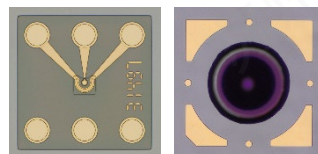
此简介所提供的信息如有更改，恕不另行通知。Albis Optoelectronics AG 对于未授权的更改及其导致的不准确之处不承担任何责任。版权所有 © 2021 Albis Optoelectronics AG.

PAM-4 解决方案



28 Gbaud 光电探测器

- 芯片尺寸小，性价比高
- 正照大光学孔径，易于光耦合
- G-S-G 焊盘结构
- 适用于28 Gbaud PAM-4



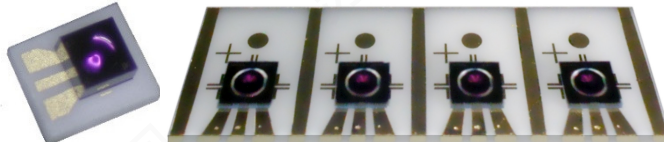
28 / 56 Gbaud 带镜头的背照光电探测器

- 光电探测器背部自带集成镜头，易于光耦合
- 可提供芯片或带衬底的芯片
- 适用于28 / 56 Gbaud PAM-4



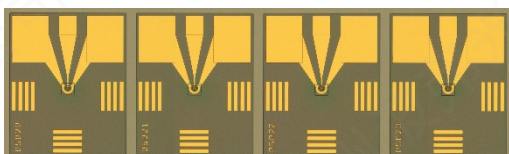
56 Gbaud 高响应光电探测器

- 芯片尺寸小，性价比高
- 响应度高达 0.8 A/W
- 适用于 56 Gbaud PAM-4
- 适用于 100G Single Lambda



28 / 56 / 112 Gbaud 带衬底的光电探测器

- 背部照明的超高速光电探测器贴片于陶瓷衬底
- 光电探测器背部自带集成镜头，易于光耦合
- 可提供高精度，多通道贴装
- 可定制衬底
- 每通道速率可达 28 Gbaud 至 112 Gbaud PAM-4
- 适用于 400GBASE-DR4, 400G-FR4
- 适用于 800GbE



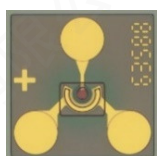
4 x 56 Gbaud 光电探测器阵列

- 通道间距为 500 μm 的四通道光电探测器阵列
- 每通道各自拥有G-S-G 焊盘结构
- 每通道可支持 56 Gbaud PAM-4
- 适用于 400GBASE-DR4, 400G-FR4



28 Gbaud 带镜头的背照 APD

- APD 背部自带集成镜头，易于光耦合
- 实现了高灵敏度的 28G 光接收机
- 高达 +5 dBm 的光损伤阈值
- 提供芯片或带衬底的芯片(Chip-on-Submount)
- 可定制衬底
- 适用于 28 Gbaud PAM-4
- 适用于 100GBASE-ER4



28 Gbaud 正照雪崩二极管

- 实现了高灵敏度的 28G 光接收机
- 高达 +5 dBm 的光损伤阈值
- 为 TO-can 组装而优化的芯片尺寸
- 适用于 28 Gbaud PAM-4
- 适用于 100GBASE-ER4